








	<p>SI3442BDV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3442BDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3442BDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 118004 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3442BDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	118004 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	860mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	57 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)























SI3442BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3442BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3442BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3442BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3442BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3442CDV V V TSOP-6</p>	 <p>SI3442BDV-T1 VISHAY VISHAY sot163</p>	 <p>SI3442BDV VISHAY SI3442BDV VISHAY</p>
 <p>SI3442CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 8A 6TSOP</p>	 <p>SI3442BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3442BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3442 42PR SI SI SOT-163</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3437DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-GE3
 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-GE3
 SI3440DV-T1-GE3	 SI3441BDV	 SI3441BDV-T1	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-E3
 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441DV	 SI3441DV-NL	 SI3441DV-T1
 SI3441DV-T1-E3	 SI3441DV-T2	 SI3441DV-TI-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3
 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442DV
 SI3442DV	 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3
 SI3443BDV	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3
 SI3443BVD	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443CDV-T1-GE3
 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited